ヲ　発振器又は発振機能を有する組立品であって、次の（一）及び（二）に該当するように設計したもの

（一）　動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ超一〇キロヘルツ未満において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの

$$20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-126$$

（二）　動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ以上五〇〇キロヘルツ未満において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの

$$20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-114$$

ワ　周波数シンセサイザーを用いた組立品のうち、次のいずれかに該当するもの

（一）　周波数切換えの所要時間が三一二ピコ秒未満のもの

（二）　三・二ギガヘルツ超一〇・六ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、一・六ギガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が一〇〇マイクロ秒未満のもの

（三）　一〇・六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、五五〇メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が二五〇マイクロ秒未満のもの

（四）　三一・八ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、五五〇メガヘルツを超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が五〇〇マイクロ秒未満のもの

（五）　四三・五ギガヘルツを超える合成出力周波数範囲で、周波数切換えの所要時間が一ミリ秒未満のもの

第六条第三号中「信号処理装置であって、次のいずれかに該当するもの」の下に「（特定の帯域通過、低域通過、高域通過、帯域阻止又は共振の機能のいずれかのみを有するものを除く。）」を加え、同号イ（二）1中「五五デシベル」を「六五デシベル」に改め、同号イ（三）3中「五五デシベル」を「六五デシベル」に改め、同号ロ中「二・五ギガヘルツ」を「六ギガヘルツ」に改める。

第六条第八号を次のように改める。

八　回転入力型のアブソリュートエンコーダであって、角度の変換誤差の絶対値が一秒以下のもの

第六条第八号の二中「鉄道又は航空機用に」を「鉄道車両又は航空機に使用するように」に改め、「及び他の貨物に使用するように設計したもの」を削り、同号の次に次の一号を加える。

八の三　電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュールであって、次の（イ）から（ハ）までのすべてに該当するもの（民生用の自動車、鉄道車両又は航空機に使用するように設計された装置に組み込まれたものを除く。）

（イ）　最大動作接合部温度が二一五度を超えるように設計したもの

（ロ）　繰返しピーク休止状態電圧が三〇〇ボルトを超えるもの

（ハ）　継続電流が一アンペアを超えるもの

第六条第十一号を次のように改める。

十一　削除

第六条第十三号中「及び他の貨物に使用するように設計したもの」を削り、同号ハ中「あらゆる」を「いずれかの」に改め、同号ハ（一）中「一〇ナノ秒」を「三一二ピコ秒」に改め、同号ニを次のように改める。

ニ　最大合成出力周波数が三・二ギガヘルツを超え、次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇ヘルツ超一〇キロヘルツ未満において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの

$$20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-126$$

（二）　動作周波数とオフセット周波数の隔たりが一〇キロヘルツ以上五〇〇キロヘルツ未満において、搬送波に対する一ヘルツ当たりの単側波帯位相雑音の比が次に掲げる式により算定した値未満のもの

$$20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-20\log_{10}\left(\frac{\text{メガヘルツで表した動作周波数}}{\text{ヘルツで表した動作周波数とオフセット周波数の隔たり}}\right)-114$$

第六条第十四号を次のように改める。

十四　ネットワークアナライザーであって、次のいずれかに該当するもの

イ　最大動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七〇ギガヘルツ以下であって、かつ、出力が三一・六二ミリワットを超えるもの

ロ　最大動作周波数が七〇ギガヘルツを超えるもの

第六条第十七号中「製造用の装置」の下に「（ホにおいて「半導体製造装置」という。）」を加え、同号ハを次のように改める。

ハ　異方性プラズマドライエッチング装置であって、次の（一）及び（二）に該当するもの

（一）　パターンを形成する線の最小線幅が六五ナノメートル以下の回路を実現することができるもの

（二）　ウエハーの外縁から二ミリメートル以下の範囲を除外したウエハーの表面におけるパターンを形成する線の最小線幅の不均一性が、三シグマの分布において一〇パーセント以下の範囲に収まるようにウエハーを加工することができるもの

第六条第十七号ホ（一）を次のように改める。

（一）　イ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当する半導体製造装置であってそれぞれ異なるものを三台以上接続することができるように設計したウエハーの出し入れ用の接続部を有するもの（異なる機能を有するものを接続することができるものに限る。）

第六条第十七号ホ（二）中「連続して」を「順次」に改める。

第七条第一号ハを削り、同条第三号ハ及びホ中「〇・七五実効テラ演算」を「一・五実効テラ演算」に改め、同号チを次のように改める。

チ　デジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル計算機の間でデータを転送するように設計した装置であって、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるもの

第八条第五号の三ロ中「、及びこれを」を「、かつ、これを」に改め、同号に次のように加える。

ハ　使用されている移動通信プロトコルを利用するもの

第八条第八号の二イを次のように改める。

イ　レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの

（一）　一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの

（二）　レーザー光を増幅する機能を有するものであって、プラセオジムを添加したふっ化物を用いた光ファイバーを用いたもの

（三）　コヒーレント伝送方法を用いたもの

（四）　アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの（テレビジョン放送（有線テレビジョン放送を含む。）用の装置を除く。）

第八条第八号の二中ロ及びハを削り、ニをロとし、ホをハとする。

第八条第九号中「からヲまで」を「からカまで」に、「その部分品」を「これらの部分品（暗号機能を実現するために設計した部分品に限る。）」に改め、同号へを次のように改める。

へ　暗号機能を有するスマートカード又はそのリーダライタであって、次のいずれかに該当するもの

（一）　スマートカードであって、次のいずれかに該当するもの

1　トからカまでのいずれかに該当する装置に限定されて使用するものであって、他の用途のためにプログラムの書き換えを行うことができないもの